

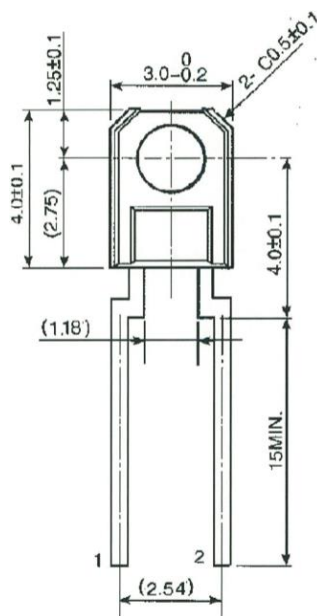
正面



側面



外形



特長

4つの技術を採用し、品質事故リスクを 極限まで低減した高い品質と耐久性を実現

1. パラジウムめっきフレーム使用で、高い耐久性を実現

一般的には製品完成後に半田めっきを行います。完成後めっきでは、めっき液が侵入し、品質事故につながる可能性があります。弊社製品は、プレめっきのため、その恐れがありません。

2. 低温アセンブリで、部材酸化による品質劣化なし

低温速硬化ダイボンドにより、チップ・フレーム・樹脂の高密着性を実現しています。またフレームの酸化防止・不純物の折出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。

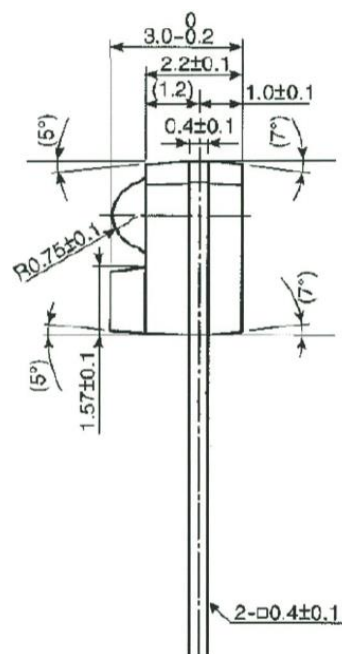
3. 高信頼の樹脂/構造の採用

高信頼性モールド樹脂、減圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止。

4. エピウエハーを採用し、大電流域でも安定動作

エピウエハーの採用により、 $V_{ce(sat)}$ が他社比較で40%程度低く、段電流域でも安定動作を実現しています。

ピン接続図



※ () は参考値

定格及び特性

絶対最大定格

Ta=25℃

項目	記号	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・コレクタ間電圧	V_{ECO}	5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	75	mW
コレクタ損失低減率(Ta>25℃)	$\Delta P_C / ^\circ C$	-1	mw/°C
動作温度	T_{opr}	-30 ~+95	°C
保存温度	T_{stg}	-40 ~+100	°C
はんだ付け温度(5 s)	T_{sol}	260 ^{*1}	°C

*1: リード根元より2mm以上

電氣的及び光学的特性

Ta=25℃

項目		記号	条 件	MIN	TYP	MAX	単位
暗電流		ICEO	$V_{CE}=24V, E=0$	-	0.005	0.1	μA
光電流		IL	$E=0.1mW/cm^2$ $V_{CE}=3V$	50	130	210	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$E=0.1mW/cm^2$ $I_L=15\mu A$	-	0.15	0.4	V
ピーク感度波長		λ	-	-	870	-	nm
半値角		1/2θ	-	-	±15	-	°
応答時間	上昇時間	t_r	$V_{CE}=5V, I_C=2mA,$ $R_L=100\Omega$	-	6	-	μs
	下降時間	t_f		-	6	-	μs

